

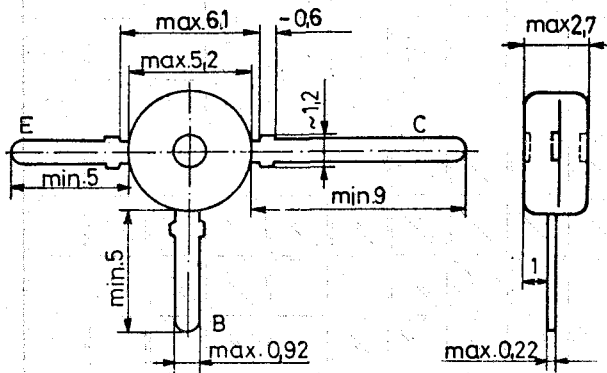
M.E.V.

MIKROELEKTRONIKAI  
VÁLLALAT

IV., Fóti út 56.

1325 Budapest, Pf. 21 Telefon: 691-100 Telex: 22-7306

**BFT 95**  
**Szilícium PNP planár**  
**RF tranzisztor**



Tak: TO 50  
Tömeg: kb. 0,25g

Méreték mm-ben

1. ábra

*Ajánlott alkalmazás*

RF erősítőkben GHz tartományig, különösen szélessávú antennaerősítőkben.

*Jellegzetes tulajdonságok*

- Nagy teljesítményerősítés
- Alacsony zajtényező
- Magas tranzitfrekvencia

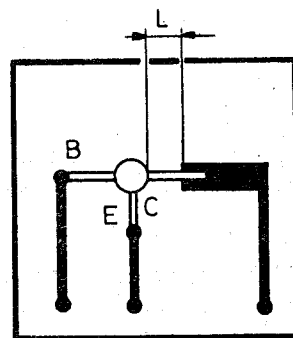
**HÖELLENÁLLÁS**

$R_{thja} = 300 \text{ K/W}$

$l = 8 \text{ mm}$

$t_L = \text{állandó}$

30x30x1,5mm  
üvegszálás  
ábra szerinti  
áramköri lapra  
szerelve



2. ábra

MAXIMÁLIS HATÁRADATOK	JELÖLÉS	BFT 95	EGYSÉG
Kollektor-bázis feszültség	$-V_{CB0}$	15	V
Koilektor-emitter feszültség	$-V_{CE0}$	15	V
Emitter-bázis feszültség	$-V_{EB0}$	3	V
Kollektor egyenáram	$-I_C$	25	mA
Kollektor áram csúcsértéke $f \geq 1\text{MHz}$	$-I_{CM}$	50	mA
Bázis áram $f \geq 1\text{MHz}$	$-I_B$	3	mA
TELJES TELJESÍTMÉNYDISSIPÁCIÓ (lásd 2. ábra)	$P_{tot}$	200	mW
Átmenet hőmérséklete	$T_j$	150	°C
Tárolási hőmérséklet	$T_s$	- 55... + 150	°C

SZTATIKUS JELLEMZŐK T = 25°C ha másként nincs meghatározva	JELÖLÉS	BFT 95	EGYSÉG
Kollektor-bázis visszáram -V <sub>CB</sub> = 10V	-I <sub>CBO</sub>	≤ 50	nA
Kollektor-bázis letörési feszültség -I <sub>C</sub> = 10μA , I <sub>E</sub> = 0	-V <sub>(BR)CBO</sub>	≥ 15	V
Kollektor-emitter letörési feszültség -I <sub>C</sub> = 3mA , I <sub>B</sub> = 0	-V <sub>(BR)CEO</sub> *	≥ 15	V
Emitter-bázis letörési feszültség -I <sub>E</sub> = 10μA , I <sub>C</sub> = 0	-V <sub>(BR)EBO</sub>	≥ 3	V
Egyenáramú áramerősítési tényező -V <sub>CE</sub> = 5V , -I <sub>C</sub> = 10mA	h <sub>21E</sub>	≥ 25 , 60	

\*  $\frac{t_p}{T} = 0,01$ ,  $t_p = 0,3$  ms

DINAMIKUS JELLEMZŐK T <sub>amb</sub> = 25°C	JELÖLÉS	BFT 95	EGYSÉG
Tranzit frekvencia -V <sub>CB</sub> = 10V , -I <sub>C</sub> = 15mA , f = 500MHz	f <sub>T</sub>	5	GHz
Visszaható kapacitás -V <sub>CE</sub> = 10V , -I <sub>C</sub> = 10mA , f = 200MHz	C <sub>üre</sub>	0,5	pF
Kollektor-bázis kapacitás -V <sub>CB</sub> = 10V , f = 1MHz	C <sub>CBO</sub>	0,5	pF
Zaj tényező -V <sub>CB</sub> = 10V , -I <sub>C</sub> = 3mA , R <sub>G</sub> = R <sub>Gop1</sub> f = 500MHz f = 1GHz	F F	17 2	dB dB
Teljesítmény erősítés -V <sub>CB</sub> = 10V , -I <sub>C</sub> = 15mA , f = 1GHz	G <sub>pb</sub>	12	dB
Átviteli együttható -V <sub>CE</sub> = 10V , -I <sub>C</sub> = 15mA f = 1GHz , R <sub>g</sub> = R <sub>1</sub> = 50 ohm	(S <sub>21e</sub> ) <sup>2</sup>	10	dB

Bármely alkalmazástechnikai kérdésben a MEV Félvezető Ágazat Fejlesztése készséggel áll felhasználóink rendelkezésére (Telefon: 692-800/2337). Schronk László



**M.E.V. MIKROELEKTRONIKAI VÁLLALAT**